



美光發布第六年永續經營報告 多項目標取得進展 強調推動創新和社會進步的承諾不變

May 4, 2021

2021 年 4 月 22 日，美國愛達荷州博伊西 —美光科技 (Nasdaq: MU) 日前發布「[快速向前：美光 2021 年永續經營報告](#)」，強調公司即使在非常時期，依然致力於推動創新、人才培育、社群共好和卓越製造，展現了高度韌性。

在新冠病毒 (COVID-19) 疫情期間，美光持續推動永續發展計劃，取得進展與成果，像是展開初步投資，以兌現在 2028 年前挹注約 10 億美元達成環境保護的目標。這些目標包括與 2018 年相比，降低溫室氣體 (GHG) 排放量 75%；2030 年達到節水 75% 和全球廢棄物轉換率 95%；美光也計畫於 2025 年底，實現全美製造業務 100% 採購再生能源。與 2018 年相比，美光在 2020 年每單位生產的溫室氣體排放量減少了 36%。此外，美光的材料和廢棄物再利用、回收和再生率於 2020 年提高了 84%，比上一年增加了三個百分點。

美光在多元、平等和包容承諾上也有顯著的進展。公司實現了對弱勢族群的全面全球薪酬平等，包含基本薪資、獎金和配股獎勵。為了支持少數族群的發展，美光調整資金配置，將 2.5 億美元的現金以及等價物品，轉由少數族群所經營的金融機構進行管理。此外，美光增加了董事會的女性代表人數，截至 2021 年 2 月，美光董事會的女性代表佔比已達 50%。2020 年，員工資源團體 (ERG) 的總人數成長了 84%。ERG 由美光員工志願組成，關注具有共同身份或經歷的人及盟友，ERG 是美光內部及員工周邊社群中提倡包容價值的關鍵。

美光總裁暨執行長 Sanjay Mehrotra 表示：「我們視永續發展為美光商業模式的基石，透過挹注 10 億美元和採用科學方法追蹤成果展現支持。2020 年，我們在諸多目標上取得重大進展。面對疫情帶來的不確定性，美光達到三倍的年度節能效果，增進溫室氣體排放減量目標，並實現全面公平薪資，成為邁向全體員工包容的關鍵一步。」

美光在為社群帶來積極改變方面亦樹立了新的里程碑。2020 年，美光基金會向慈善組織捐助了近 2,400 萬美元，其中包括 1,000 萬美元的 COVID-19 救助基金；同時也透過全球科學、技術、工程和數學 (STEM) 計畫的年度資助，讓團隊成員配對計畫成長四倍，觸及超過 650,000 名學生和教育工作者。

加速永續發展和技術領先

美光有史以來，首度鞏固了其在 DARM 和 NAND 技術的領導地位。美光的 1α DRAM 技術改善記憶體容量達 40%，同時實現了業界功耗最低的行動 DRAM，節電率提高了 15%^[1]。美光的 176 層 3D NAND 快閃記憶體改進了讀/寫延遲達 35% 以上，資料傳輸率達 33%^[2]。這些技術為全新且更有效率的裝置體驗和創新基礎設施—從資料中心到智慧邊緣，奠定資料儲存的基石。

此外，美光最近推出車用 LPDDR5，功耗效率提升 20% 以上^[3]。此一節能 DRAM 可以最低的功耗支援智慧型車輛的高效能運算，進而減少交通運輸的溫室氣體排放量。美光去年九月推出突破性的繪圖記憶體 GDDR6X，每傳輸功耗率 (pJ/bit) 比前幾代更低，非常適合耗能、高頻寬的應用程式。GDDR6X 也具備調整功率高低的機能，讓使用者得以根據需求，在必要時降低效能以節省耗能。

來自多方的肯定

美光取得北美道瓊永續發展指數的認可，所有製造設施皆榮獲責任商業聯盟 (Responsible Business Alliance) 白金認證，且被評選為 2019-2020 年卓越職場 (Great Place to Work)。2021 年 3 月，根據 Sustainalytics 的環境、社會和公司治理評鑑，美光在半導體產業排名前 10%。美光也是 2019-2020 年富時社會責任指數系列成員 (FTSE Russell)，並名列《新聞週刊》2020 美國最負責任企業 (America's Most Responsible Companies)。

美光第六屆年度永續經營報告係根據全球報告倡議組織的核心準則，以及永續會計準則委員會的半導體產業準則編制而成。

關於 Micron Technology, Inc.

我們是創新記憶體和儲存空間解決方案的業界先驅，正在改變世界使用資訊的方式，豐富所有人的生活。美光持續關注於客戶、技術優勢，以及製造和卓越營運，並透過美光 (Micron®) 和 Crucial® 品牌提供高效能的 DRAM、NAND 和 NOR 記憶體以及儲存產品的豐富系列產品。美光持續的創新推動了資料經濟、人工智慧和 5G 應用程式的進步，進而激發從資料中心到智慧邊緣以及客戶端和行動裝置使用者體驗等各種新的機會。如需有關 Micron Technology, Inc. (Nasdaq: MU) 的詳細資訊，請瀏覽 www.micron.com。

© 2021 Micron Technology, Inc. 保留所有權利。資訊、產品和 / 或規格若有變動，恕不另行通知。美光、美光標誌及其他所有美光商標皆為 Micron Technology, Inc. 資產。其他所有商標皆屬其各自擁有者所有。

前瞻聲明

本新聞稿包含有關我們對環境目標的前瞻聲明。這些前瞻聲明並不保證我們的環境目標將會實現，並且會受到許多風險和不確定性的影響，可能會導致實際結果出現重大差異。請參閱我們提交給證券交易委員會的文件，特別是我們最近的 10-K 表和 10-Q 表。這些文件包含並確定了可能導致我們實際結果與這些前瞻性聲明中包含的結果之間存在重大差異的重要因素。可以在 www.micron.com/certainfactors 找到這些因素。儘管我們相信前瞻性聲明中反映的期望是合理的，但我們不能保證未來的結果、活動等級、績效或成就。我們沒有義務在本發佈日期後更新任何前瞻性聲明，以使這些聲明符合實際結果。

美光媒體關係聯絡人

Erica Pompen
Micron Technology, Inc.
+1 (408) 834-1873
epompen@micron.com

美光投資人關係聯絡人

Farhan Ahmad
Micron Technology, Inc.
+1 (408) 834-1927
farhanahmad@micron.com

[\[1\]](#) 與美光先前 1z 代行動 DRAM 相比較

[\[2\]](#) 比較依據為美光的高容量、浮閘式 96 層 NAND。在與 128 層替代閘極 NAND 比較時，美光 176 層 NAND 在讀和寫的延遲同時改善了超過 25%。

[\[3\]](#) 與 LPDDR4x 前幾代比較